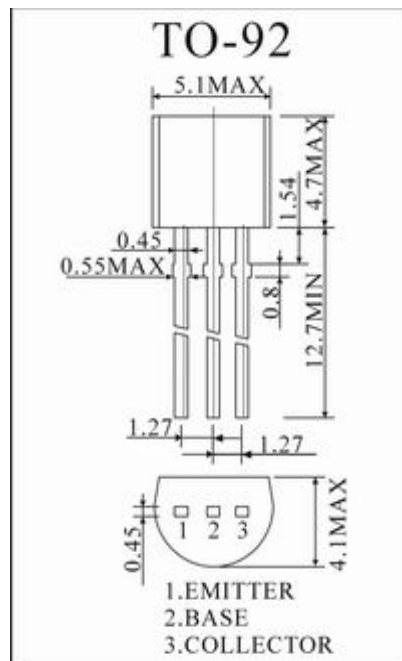


■■主要用途：功率放大等。

■■绝对最大额定值 (Ta=25℃)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极—基极电压	V _{CBO}	40	V
集电极—发射极电压	V _{CEO}	25	V
发射极—基极电压	V _{EBO}	6	V
集电极电流	I _C	800	mA
集电极耗散功率	P _C	800	mW
结 温	T _J	150	℃
存储温度	T _{stg}	- 55~150	℃



■■电参数 (Ta=25℃)

项 目	符 号	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	h _{FE}	85		300		V _{CE} = 1 V, I _C = 100 mA
集电极-基极截止电流	I _{CBO}			0.1	μ A	V _{CB} = 35 V, I _E =0
发射极-基极截止电流	I _{EBO}			0.1	μ A	V _{EB} = 6 V, I _C =0
集电极-基极击穿电压	BV _{CBO}	40			V	I _C = 0.1 mA, I _E =0
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	25			V	I _C = 2 mA, I _B =0
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	6			V	I _E = 0.1 mA, I _C =0
基极-发射极电压	V _{BE}			1	V	V _{CE} = 1V, I _C = 10 mA
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}			0.5	V	I _C = 500 mA, I _B = 50 mA
基极-发射极饱和压降	V _{BE(sat)}			1.2	V	I _C =500 mA, I _B = 50 mA
电流增益-带宽乘积	f _T	100			MHz	I _C = 50 mA, V _{CE} = 10 V
共基极输出电容	C _{ob}		9	20	PF	V _{CB} = 10 V, I _E =0, f = 1 MHz

■■h_{FE} 分档及其标志

分档	B	C	D
h _{FE}	85~160	120~200	160~300